

MBRH200150 thru MBRH200200R

Silicon Power Schottky Diode

 $V_{RRM} = 150 V - 200 V$

 $I_{F(AV)} = 200 A$

Features

- High Surge Capability
- \bullet Types from 150 V to 200 V V_{RRM}
- Not ESD Sensitive

D-67 Package











Maximum ratings, at $T_j = 25$ °C, unless otherwise specified ("R" devices have leads reversed)

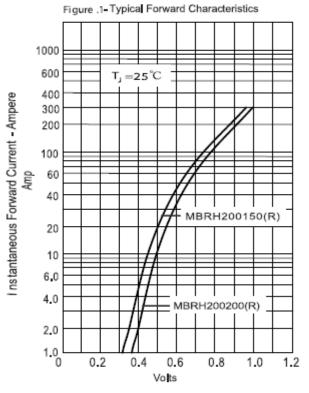
Parameter	Symbol	Conditions	MBRH200150(R)		MBRH200200(R)	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		150		200	V
RMS reverse voltage	V_{RMS}		106		141	V
DC blocking voltage	V_{DC}		150		150	V
Operating temperature	T _j		-55 to 150		-55 to 150	°C
Storage temperature	T _{stg}		-55 to 150	4	-55 to 150	°C

Electrical characteristics, at Tj = 25 °C, unless otherwise specified

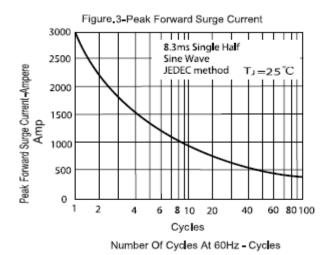
Parameter	Symbol	Conditions	MBRH200150(R)	MBRH200200(R)	Unit
Average forward current (per pkg)	I _{F(AV)}	T _C = 125 °C	200	200	А
Peak forward surge current	I_{FSM}	t_p = 8.3 ms, half sine	3000	3000	Α
Maximum instantaneous forward voltage	V_{F}	I _{FM} = 200 A, T _j = 25 °C	0.88	0.92	V
Maximum instantaneous reverse current at rated DC blocking voltage	I _R	$T_j = 25 \text{ °C}$ $T_j = 100 \text{ °C}$ $T_j = 150 \text{ °C}$	1 10 50	1 10 50	mA
Thermal characteristics					
Thermal resistance, junction- case	R_{oJC}		0.35	0.35	°C/W

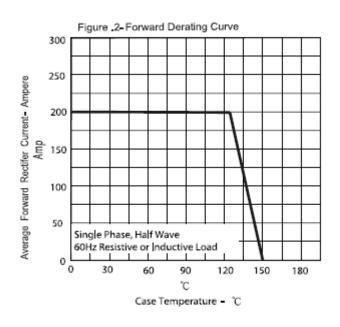


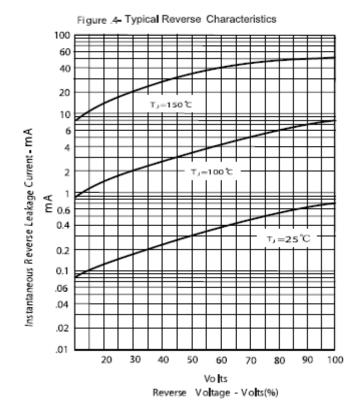
MBRH200150 thru MBRH200200R







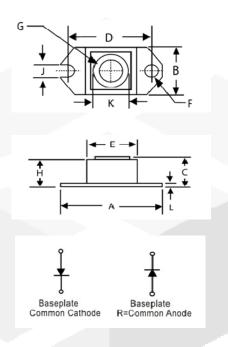




MBRH200150 thru MBRH200200R

Package dimensions and terminal configuration

Product is marked with part number and terminal configuration.



DIME NS IONS							
DIM	INCHES		М	NOTE			
	MIN	MAX	MIN	MAX			
Α	1.515	1.560	38.48	39.62			
В	.725	.775	18.42	19.69			
С	.595	.625	15.11	15.88			
D	1.182	1.192	30.02	30.28			
E	.736	.744	18.70	18.90			
F	.152	.160	3.86	4.061	Ø		
G							
Н	.540	.580	13.72	14.73			
J	.156	.160	3.96	4.06			
K	.480	.492	12.20	12.50	Ø		
L	.120	.130	3.05	3.30			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

GeneSiC Semiconductor:

MBRH200150 MBRH200200 MBRH200150R MBRH200200R MBRH200200(R)

ПОСТАВКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

многоканальный

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001 Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г. Москва, ул. Щербаковская д. 3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru moschip.ru_6 moschip.ru 4 moschip.ru 9